



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2009-0020992
(43) 공개일자 2009년02월27일

(51) Int. Cl.

G02F 1/136 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2007-0085681

(22) 출원일자 2007년08월24일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

엘지디스플레이 주식회사

서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자

안성훈

울산 북구 진장동 420-1

(74) 대리인

박장원

전체 청구항 수 : 총 14 항

(54) 액정표시장치 및 그 제조방법

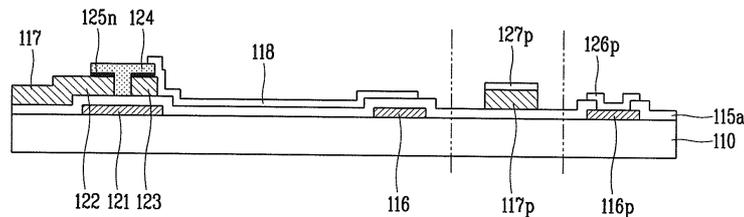
(57) 요약

본 발명의 액정표시장치 및 그 제조방법은 액티브패턴을 소오스전극과 드레인전극 위에 형성하는 한편 보호층을 생략함으로써 4마스크공정으로 박막 트랜지스터를 형성하여 비용을 절감하기 위한 것으로, 화소부와 데이터패드부 및 게이트패드부로 구분되는 제 1 기판을 제공하는 단계; 제 1 마스크공정을 통해 상기 제 1 기판의 화소부에 게이트전극과 게이트라인을 형성하는 단계; 상기 제 1 기판 위에 게이트절연막을 형성하는 단계; 제 2 마스크공정을 통해 상기 제 1 기판의 화소부에 소오스전극과 드레인전극을 형성하며, 상기 게이트라인과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터라인을 형성하는 단계; 제 3 마스크공정을 통해 상기 게이트전극 상부의 소오스전극과 드레인전극 위에 액티브패턴을 형성하는 단계; 제 4 마스크공정을 통해 상기 드레인전극의 측면과 직접 전기적으로 접속하는 화소전극을 형성하는 단계; 및 상기 제 1 기판과 제 2 기판을 합착하는 단계를 포함한다.

이와 같이 구성된 본 발명의 액정표시장치는 회절노광을 사용하지 않고 액티브패턴을 형성함으로써 일반적인 4마스크구조에서 구현이 어려운 단-채널(short channel) 박막 트랜지스터를 제조할 수 있는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 액티브패턴은 게이트전극 상부에만 아일랜드 형태로 형성되고 데이터라인 하부에는 존재하지 않게 됨으로써 화소부의 개구영역을 증가시킬 수 있으며, 또한 백라이트 광에 의해 노출되지 않기 때문에 백라이트 광에 노출되었을 때 발생하였던 웨이비 노이즈(wavy noise) 현상을 방지할 수 있는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도4d



특허청구의 범위

청구항 1

화소부와 데이터패드부 및 게이트패드부로 구분되는 제 1 기판을 제공하는 단계;

제 1 마스크공정을 통해 상기 제 1 기판의 화소부에 게이트전극과 게이트라인을 형성하는 단계;

상기 제 1 기판 위에 게이트절연막을 형성하는 단계;

제 2 마스크공정을 통해 상기 제 1 기판의 화소부에 소오스전극과 드레인전극을 형성하며, 상기 게이트라인과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터라인을 형성하는 단계;

제 3 마스크공정을 통해 상기 게이트전극 상부의 소오스전극과 드레인전극 위에 액티브패턴을 형성하는 단계;

제 4 마스크공정을 통해 상기 드레인전극의 측면과 직접 전기적으로 접속하는 화소전극을 형성하는 단계; 및

상기 제 1 기판과 제 2 기판을 합착하는 단계를 포함하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 마스크공정을 이용하여 상기 제 1 기판의 게이트패드부에 게이트패드라인을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 3

제 2 항에 있어서, 상기 제 2 마스크공정을 이용하여 상기 제 1 기판의 데이터패드부에 데이터패드라인을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 제 2 마스크공정을 이용하여 상기 소오스전극과 드레인전극 및 데이터라인 위에 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 5

제 3 항에 있어서, 상기 제 2 마스크공정을 이용하여 상기 데이터패드라인 위에 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 6

제 3 항에 있어서, 상기 제 3 마스크공정을 이용하여 상기 게이트패드라인의 일부를 노출시키는 게이트패드부 콘택홀을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 7

제 4 항에 있어서, 상기 제 3 마스크공정을 이용하여 상기 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴의 일부를 제거하여 상기 액티브패턴과 소오스전극 및 상기 액티브패턴과 드레인전극 사이에 오믹-콘택을 형성하는 오믹-콘택층을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 8

제 5 항에 있어서, 상기 제 3 마스크공정을 이용하여 상기 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴을 완전히 제거하여 상기 데이터패드라인을 노출시키는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 9

제 3 항에 있어서, 상기 제 4 마스크공정을 이용하여 상기 데이터패드라인 위에 상기 데이터패드라인과 직접 전기적으로 접속하는 데이터패드전극을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제

조방법.

청구항 10

제 5 항에 있어서, 상기 제 4 마스크공정을 이용하여 상기 게이트패드부 콘택홀을 통해 상기 게이트패드라인과 전기적으로 접속하는 게이트패드전극을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 11

제 1 항에 있어서, 상기 제 2 마스크공정을 이용하여 상기 액티브패턴의 채널영역에 위치하는 게이트절연막의 일부를 제거하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 12

화소부와 데이터패드부 및 게이트패드부로 구분되는 제 1 기판;

제 1 도전막으로 이루어지며, 상기 제 1 기판의 화소부에 형성된 게이트전극과 게이트라인 및 상기 게이트패드부에 형성된 게이트패드라인;

상기 제 1 기판 위에 형성된 게이트절연막;

제 2 도전막으로 이루어지며, 상기 제 1 기판의 화소부에 형성된 소오스전극과 드레인전극 및 상기 게이트라인과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터라인;

상기 제 2 도전막으로 이루어지며 상기 데이터패드부에 형성된 데이터패드라인;

상기 게이트전극 상부의 소오스전극과 드레인전극 위에 형성된 액티브패턴;

제 3 도전막으로 이루어지며 상기 드레인전극의 측면과 직접 전기적으로 접속하는 화소전극;

상기 제 3 도전막으로 이루어지며, 상기 데이터패드라인 및 게이트패드라인에 각각 직접 및 게이트패드부 콘택홀을 통해 전기적으로 접속하는 데이터패드전극과 게이트패드전극; 및

상기 제 1 기판과 대향하여 합착하는 제 2 기판을 포함하는 액정표시장치.

청구항 13

제 12 항에 있어서, 상기 제 1 도전막과 제 2 도전막은 알루미늄, 알루미늄 합금, 텅스텐, 구리, 크롬, 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금과 같은 불투명한 도전물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 14

제 12 항에 있어서, 상기 제 3 도전막은 인듐-틴-옥사이드(Indium Tin Oxide; ITO) 또는 인듐-징크-옥사이드(Indium Zinc Oxide; IZO)와 같은 투명한 도전물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

명세서

발명의 상세한 설명

기술분야

<1> 본 발명은 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 마스크수를 감소시켜 제조공정을 단순화하고 수율을 향상시키는 동시에 4마스크공정으로 단-채널 박막 트랜지스터를 제조할 수 있는 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

배경기술

<2> 최근 정보 디스플레이에 관한 관심이 고조되고 휴대가 가능한 정보매체를 이용하려는 요구가 높아지면서 기존의 표시장치인 브라운관(Cathode Ray Tube; CRT)을 대체하는 경량 박막형 평판표시장치(Flat Panel Display; FPD)에 대한 연구 및 상업화가 중점적으로 이루어지고 있다. 특히, 이러한 평판표시장치 중 액정표시장치(Liquid Crystal Display; LCD)는 액정의 광학적 이방성을 이용하여 이미지를 표현하는 장치로서, 해상도와 컬러표시 및

화질 등에서 우수하여 노트북이나 데스크탑 모니터 등에 활발하게 적용되고 있다.

- <3> 상기 액정표시장치는 크게 컬러필터(color filter) 기판과 어레이(array) 기판 및 상기 컬러필터 기판과 어레이 기판 사이에 형성된 액정층(liquid crystal layer)으로 구성된다.
- <4> 상기 액정표시장치에 주로 사용되는 구동 방식인 능동 매트릭스(Active Matrix; AM) 방식은 비정질 실리콘 박막 트랜지스터(Amorphous Silicon Thin Film Transistor; a-Si TFT)를 스위칭소자로 사용하여 화소부의 액정을 구동하는 방식이다.
- <5> 상기 액정표시장치의 제조공정은 기본적으로 박막 트랜지스터를 포함하는 어레이 기판의 제작에 다수의 마스크 공정(즉, 포토리소그래피(photolithography)공정)을 필요로 하므로 생산성 면에서 상기 마스크수를 줄이는 방법이 요구되어지고 있다.
- <6> 이하, 도 1을 참조하여 일반적인 액정표시장치의 구조에 대해서 상세히 설명한다.
- <7> 도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 분해사시도이다.
- <8> 도면에 도시된 바와 같이, 상기 액정표시장치는 크게 컬러필터 기판(5)과 어레이 기판(10) 및 상기 컬러필터 기판(5)과 어레이 기판(10) 사이에 형성된 액정층(liquid crystal layer)(30)으로 구성된다.
- <9> 상기 컬러필터 기판(5)은 적(Red; R), 녹(Green; G) 및 청(Blue; B)의 색상을 구현하는 다수의 서브-컬러필터(7)로 구성된 컬러필터(C)와 상기 서브-컬러필터(7) 사이를 구분하고 액정층(30)을 투과하는 광을 차단하는 블랙매트릭스(black matrix)(6), 그리고 상기 액정층(30)에 전압을 인가하는 투명한 공통전극(8)으로 이루어져 있다.
- <10> 또한, 상기 어레이 기판(10)은 종횡으로 배열되어 복수개의 화소영역(P)을 정의하는 복수개의 게이트라인(16)과 데이터라인(17), 상기 게이트라인(16)과 데이터라인(17)의 교차영역에 형성된 스위칭소자인 박막 트랜지스터(T) 및 상기 화소영역(P) 위에 형성된 화소전극(18)으로 이루어져 있다.
- <11> 이와 같이 구성된 상기 컬러필터 기판(5)과 어레이 기판(10)은 화상표시 영역의 외곽에 형성된 실런트(sealant)(미도시)에 의해 대향하도록 합착되어 액정표시패널을 구성하며, 상기 컬러필터 기판(5)과 어레이 기판(10)의 합착은 상기 컬러필터 기판(5) 또는 어레이 기판(10)에 형성된 합착키(미도시)를 통해 이루어진다.
- <12> 도 2a 내지 도 2e는 도 1에 도시된 액정표시장치에 있어서, 어레이 기판의 제조공정을 순차적으로 나타내는 단면도이다.
- <13> 도 2a에 도시된 바와 같이, 어레이 기판(10) 위에 포토리소그래피공정(제 1 마스크공정)을 이용하여 도전성 금속물질로 이루어진 게이트전극(21)을 형성한다.
- <14> 다음으로, 도 2b에 도시된 바와 같이, 상기 게이트전극(21)이 형성된 어레이 기판(10) 전면(全面)에 차례대로 제 1 절연막(15a)과 비정질 실리콘 박막 및 n+ 비정질 실리콘 박막을 증착한 후, 포토리소그래피공정(제 2 마스크공정)을 이용하여 상기 비정질 실리콘 박막과 n+ 비정질 실리콘 박막을 선택적으로 패터닝함으로써 상기 게이트전극(21) 위에 상기 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 액티브패턴(24)을 형성한다.
- <15> 이때, 상기 액티브패턴(24) 위에는 상기 액티브패턴(24)과 동일한 형태로 패터닝된 n+ 비정질 실리콘 박막 패턴(25)이 형성되게 된다.
- <16> 이후, 도 2c에 도시된 바와 같이, 상기 어레이 기판(10) 전면(全面)에 도전성 금속물질을 증착한 후 포토리소그래피공정(제 3 마스크공정)을 이용하여 선택적으로 패터닝함으로써 상기 액티브패턴(24) 상부에 소오스전극(22)과 드레인전극(23)을 형성한다. 이때, 상기 액티브패턴(24) 위에 형성되어 있는 n+ 비정질 실리콘 박막 패턴은 상기 제 3 마스크공정을 통해 소정영역이 제거되어 상기 액티브패턴(24)과 소오스/드레인전극(22, 23) 사이에서 오믹-콘택(ohmic contact)층(25')을 형성하게 된다.
- <17> 다음으로, 도 2d에 도시된 바와 같이, 상기 소오스전극(22)과 드레인전극(23)이 형성된 어레이 기판(10) 전면(全面)에 제 2 절연막(15b)을 증착한 후, 포토리소그래피공정(제 4 마스크공정)을 통해 상기 제 2 절연막(15b)의 일부 영역을 제거하여 상기 드레인전극(23)의 일부를 노출시키는 콘택홀(40)을 형성한다.
- <18> 마지막으로, 도 2e에 도시된 바와 같이, 투명한 도전성 금속물질을 어레이 기판(10) 전면(全面)에 증착한 후 포토리소그래피공정(제 5 마스크공정)을 이용하여 선택적으로 패터닝함으로써 상기 콘택홀(40)을 통해 드레인전극(23)과 전기적으로 접속하는 화소전극(18)을 형성한다.

- <19> 상기에 설명된 바와 같이 박막 트랜지스터를 포함하는 어레이 기관의 제조에는 게이트전극, 액티브패턴, 소오스/드레인전극, 콘택홀 및 화소전극 등을 패터닝하는데 총 5번의 포토리소그래피공정을 필요로 한다.
- <20> 상기 포토리소그래피공정은 마스크에 그려진 패턴을 박막이 증착된 기관 위에 전사시켜 원하는 패턴을 형성하는 일련의 공정으로 감광액 도포, 노광, 현상공정 등 다수의 공정으로 이루어지며, 다수의 포토리소그래피공정은 생산 수율을 떨어뜨리는 단점이 있다.
- <21> 특히, 패턴을 형성하기 위하여 설계된 마스크는 매우 고가이어서, 공정에 적용되는 마스크수가 증가하면 액정표시장치의 제조비용이 이에 비례하여 상승하게 된다.
- <22> 이때, 회절마스크를 이용하여 액티브패턴과 소오스/드레인전극을 한번의 마스크공정으로 형성함으로써 총 4번의 마스크공정으로 어레이 기관을 제작할 수 있는 기술이 개발되었다.
- <23> 그러나, 상기 구조의 액정표시장치는 회절마스크를 이용함으로써 두 번의 식각공정을 거쳐 액티브패턴과 소오스/드레인전극을 패터닝하게 됨에 따라 상기 소오스전극과 드레인전극 및 데이터라인의 하부 주변으로 액티브패턴이 돌출하여 남아있게 된다.
- <24> 상기 액티브패턴은 순수한 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며, 상기 돌출된 액티브패턴은 하부의 백라이트 광에 노출됨으로써 상기 백라이트 광에 의해 광전류가 발생하게 된다. 이때, 상기 백라이트 광의 미세한 깜빡임으로 인해 상기 비정질 실리콘 박막은 미세하게 반응하여 활성화와 비활성화 상태가 반복되게 되며, 이로 인해 광전류에 변화가 발생하게 된다. 이와 같은 광전류 성분은 이웃하는 화소전극에 흐르는 신호와 함께 커플링(coupling)되어 상기 화소전극에 위치한 액정의 움직임을 왜곡시키게 한다. 그 결과 액정표시장치의 화면에는 물결무늬의 가는 선이 나타나는 웨이비 노이즈(wavy noise)가 발생하게 된다.
- <25> 또한, 상기 데이터라인의 하부에 위치한 액티브패턴은 상기 데이터라인의 양측으로 소정거리 돌출됨으로써 화소부의 개구영역이 상기 돌출된 거리만큼 잠식됨에 따라 액정표시장치의 개구율이 감소하는 문제가 있다.
- <26> 또한, 전술한 바와 같이 회절마스크를 사용하여 액티브패턴을 형성함에 따라 채널 길이가 4 μ m 이하의 단-채널 박막 트랜지스터를 제조하는데 어려움이 있다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- <27> 본 발명은 상기한 문제를 해결하기 위한 것으로, 4번의 마스크공정으로 액티브패턴의 테일이 없는 어레이 기관을 제작하도록 한 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공하는데 목적이 있다.
- <28> 본 발명의 다른 목적은 개구영역을 확대하여 고휘도를 구현할 수 있는 동시에 웨이비 노이즈가 발생하지 않아 고화질을 구현할 수 있는 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.
- <29> 본 발명의 다른 목적은 회절노광을 사용하지 않고 액티브패턴을 형성함으로써 박막 트랜지스터의 단-채널을 구현할 수 있는 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.
- <30> 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 후술되는 발명의 구성 및 특허청구범위에서 설명될 것이다.

과제 해결수단

- <31> 상기한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 액정표시장치는 화소부와 데이터패드부 및 게이트패드부로 구분되는 제 1 기관; 제 1 도전막으로 이루어지며, 상기 제 1 기관의 화소부에 형성된 게이트전극과 게이트라인 및 상기 게이트패드부에 형성된 게이트패드라인; 상기 제 1 기관 위에 형성된 게이트절연막; 제 2 도전막으로 이루어지며, 상기 제 1 기관의 화소부에 형성된 소오스전극과 드레인전극 및 상기 게이트라인과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터라인; 상기 제 2 도전막으로 이루어지며 상기 데이터패드부에 형성된 데이터패드라인; 상기 게이트전극 상부의 소오스전극과 드레인전극 위에 형성된 액티브패턴; 제 3 도전막으로 이루어지며 상기 드레인전극의 측면과 직접 전기적으로 접속하는 화소전극; 상기 제 3 도전막으로 이루어지며, 상기 데이터패드라인 및 게이트패드라인에 각각 직접 및 게이트패드부 콘택홀을 통해 전기적으로 접속하는 데이터패드전극과 게이트패드전극; 및 상기 제 1 기관과 대향하여 합착하는 제 2 기관을 포함한다.
- <32> 또한, 본 발명의 액정표시장치의 제조방법은 화소부와 데이터패드부 및 게이트패드부로 구분되는 제 1 기관을 제공하는 단계; 제 1 마스크공정을 통해 상기 제 1 기관의 화소부에 게이트전극과 게이트라인을 형성하는 단계;

상기 제 1 기판 위에 게이트절연막을 형성하는 단계; 제 2 마스크공정을 통해 상기 제 1 기판의 화소부에 소오스전극과 드레인전극을 형성하며, 상기 게이트라인과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터라인을 형성하는 단계; 제 3 마스크공정을 통해 상기 게이트전극 상부의 소오스전극과 드레인전극 위에 액티브패턴을 형성하는 단계; 제 4 마스크공정을 통해 상기 드레인전극의 측면과 직접 전기적으로 접속하는 화소전극을 형성하는 단계; 및 상기 제 1 기판과 제 2 기판을 합착하는 단계를 포함한다.

효 과

- <33> 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치 및 그 제조방법은 박막 트랜지스터 제조에 사용되는 마스크수를 줄여 제조공정 및 비용을 절감시키는 효과를 제공한다.
- <34> 또한, 본 발명에 따른 액정표시장치 및 그 제조방법은 액티브패턴의 테일이 존재하지 않아 데이터라인의 신호간섭이 없으며 상기 액티브패턴의 테일 폭만큼 개구율이 증가하게 된다.
- <35> 또한, 본 발명에 따른 액정표시장치 및 그 제조방법은 웨이브 노이즈가 발생하지 않는 동시에 단-채널의 구현이 가능하여 고화질의 액정표시장치를 제작할 수 있는 효과를 제공한다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- <36> 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 액정표시장치 및 그 제조방법의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
- <37> 도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치의 어레이 기판 일부를 개략적으로 나타내는 평면도이다.
- <38> 실제의 액정표시장치에서는 N개의 게이트라인과 M개의 데이터라인이 교차하여 MxN개의 화소가 존재하지만 설명을 간단하게 하기 위해 도면에는 하나의 화소를 나타내고 있다.
- <39> 도면에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 실시예의 어레이 기판(110)에는 상기 어레이 기판(110) 위에 종횡으로 배열되어 화소영역을 정의하는 게이트라인(116)과 데이터라인(117)이 형성되어 있다. 또한, 상기 게이트라인(116)과 데이터라인(117)의 교차영역에는 스위칭소자인 박막 트랜지스터가 형성되어 있으며, 상기 화소영역 내에는 상기 박막 트랜지스터에 연결되어 컬러필터 기판(미도시)의 공통전극과 함께 액정(미도시)을 구동시키는 화소전극(118)이 형성되어 있다.
- <40> 이때, 도면에는 도시하지 않았지만, 상기 어레이 기판(110)의 가장자리 영역에는 상기 게이트라인(116)과 데이터라인(117)에 각각 전기적으로 접속하는 게이트패드전극과 데이터패드전극이 형성되어 있으며, 외부의 구동회로부(driving circuit unit)로부터 인가 받은 주사신호와 데이터신호를 각각 상기 게이트라인(116)과 데이터라인(117)에 전달하게 된다.
- <41> 즉, 상기 게이트라인(116)과 데이터라인(117)은 구동회로부 쪽으로 연장되어 각각 해당하는 게이트패드라인과 데이터패드라인에 연결되며, 상기 게이트패드라인과 데이터패드라인은 상기 게이트패드라인과 데이터패드라인에 각각 전기적으로 접속된 게이트패드전극과 데이터패드전극을 통해 구동회로부로부터 각각 주사신호와 데이터신호를 인가 받게 된다.
- <42> 상기 박막 트랜지스터는 게이트라인(116)에 연결된 게이트전극(121), 데이터라인(117)에 연결된 소오스전극(122) 및 화소전극(118)에 연결된 드레인전극(123)으로 구성되어 있다. 또한, 상기 박막 트랜지스터는 상기 게이트전극(121)에 공급되는 게이트 전압에 의해 상기 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 간에 전도채널(conductive channel)을 형성하는 액티브패턴(미도시)을 포함한다.
- <43> 이때, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액티브패턴은 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며, 상기 게이트전극(121) 상부에만 아일랜드 형태로 형성됨에 따라 박막 트랜지스터의 오프전류(off current)를 감소시킬 수 있게 된다.
- <44> 또한, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 상기 액티브패턴은 상기 게이트전극(121) 상부의 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 위에 형성되는 것을 특징으로 한다.
- <45> 이때, 전단에 위치한 게이트라인(116)의 일부는 게이트절연막(미도시)을 사이에 두고 그 상부의 화소전극(118)의 일부와 중첩하여 스토리지 커패시터(storage capacitor)(Cst)를 형성하게 된다. 상기 스토리지 커패시터(Cst)는 액정 커패시터에 인가된 전압을 다음 신호가 들어올 때까지 일정하게 유지시키는 역할을 한다. 즉, 상기 어레이 기판(110)의 화소전극(118)은 컬러필터 기판의 공통전극과 함께 액정 커패시터를 이루는데, 일반적으로 상기 액정 커패시터에 인가된 전압은 다음 신호가 들어올 때까지 유지되지 못하고 누설되어 사라진다. 따라

서, 인가된 전압을 유지하기 위해서는 스토리지 커패시터(Cst)를 액정 커패시터에 연결해서 사용해야 한다.

- <46> 이러한 스토리지 커패시터(Cst)는 신호 유지 이외에도 계조(gray scale) 표시의 안정과 플리커(flicker) 및 잔상(afterimage) 감소 등의 효과를 가진다.
- <47> 여기서, 본 발명의 제 1 실시예는 액티브패턴을 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 위에 형성하는 한편 보호층을 생략함으로써 총 4번의 마스크공정을 통해 어레이 기관(110)을 제작할 수 있게 된다.
- <48> 또한, 본 발명의 제 1 실시예는 회절노광을 사용하지 않고 액티브패턴을 형성함으로써 일반적인 4마스크구조에서 구현이 어려운 단-채널 박막 트랜지스터를 제조할 수 있게 되는데, 이를 다음의 액정표시장치의 제조방법을 통해 상세히 설명한다.
- <49> 도 4a 내지 도 4d는 도 3에 도시된 어레이 기관의 III-III'선에 따른 제조공정을 순차적으로 나타내는 단면도로써, 좌측에는 화소부의 어레이 기관을 제조하는 공정을 나타내며 우측에는 차례대로 데이터패드부와 게이트패드부의 어레이 기관을 제조하는 공정을 나타내고 있다.
- <50> 또한, 도 5a 내지 도 5d는 도 3에 도시된 어레이 기관의 제조공정을 순차적으로 나타내는 평면도이다.
- <51> 도 4a 및 도 5a에 도시된 바와 같이, 유리와 같은 투명한 절연물질로 이루어진 어레이 기관(110)의 화소부에 게이트전극(121)과 게이트라인(116)을 형성한다.
- <52> 또한, 상기 어레이 기관(110)의 게이트패드부에 게이트패드라인(116p)을 형성한다.
- <53> 이때, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 상기 게이트전극(121)과 게이트라인(116) 및 게이트패드라인(116p)은 제 1 도전막을 상기 어레이 기관(110) 전면에 증착한 후 포토리소그래피공정(제 1 마스크공정)을 통해 선택적으로 패터닝하여 형성하게 된다.
- <54> 여기서, 상기 제 1 도전막으로 알루미늄(aluminium; Al), 알루미늄 합금(Al alloy), 텅스텐(tungsten; W), 구리(copper; Cu), 크롬(chromium; Cr), 몰리브덴(molybdenum; Mo), 몰리브덴 합금(MO alloy) 등과 같은 저저항 불투명 도전물질을 사용할 수 있다. 또한, 상기 제 1 도전막은 상기 저저항 도전물질이 두 가지 이상 적층된 다층구조로 형성할 수도 있다.
- <55> 다음으로, 도 4b 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 게이트전극(121)과 게이트라인(116) 및 게이트패드라인(116p)이 형성된 어레이 기관(110) 전면에 제 1 절연막(115a)과 제 2 도전막 및 n+ 비정질 실리콘 박막을 증착한 후, 포토리소그래피공정(제 2 마스크공정)을 통해 선택적으로 제거함으로써 상기 어레이 기관(110)의 화소부에 상기 제 2 도전막으로 이루어진 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 및 데이터라인(117)을 형성하는 동시에 상기 데이터패드부에 상기 제 2 도전막으로 이루어진 데이터패드라인(117p)을 형성한다.
- <56> 이때, 상기 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 및 데이터라인(117) 상부에는 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며 상기 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 및 데이터라인(117)과 동일한 형태로 패터닝된 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴(125')이 남아있으며, 상기 데이터패드라인(117p) 상부에는 상기 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며 상기 데이터패드라인(117p)과 동일한 형태로 패터닝된 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴(125'')이 남아 있게 된다.
- <57> 여기서, 상기 본 발명의 제 1 실시예에 따른 데이터라인(117)은 회절노광을 사용하여 액티브패턴과 동시에 형성하지 않아 그 하부에 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 액티브패턴의 테일(tail)이 존재하지 않게 되어 상기 액티브패턴의 테일에 의한 상기 데이터라인(117)의 신호간섭이 없게 된다. 참고로, 상기 액티브패턴의 테일은 회절마스크를 이용하여 액티브패턴과 소오스/드레인전극 및 데이터라인을 한번의 마스크공정으로 형성하는 과정에서 상기 데이터라인의 하부에 형성되게 되며, 상기 데이터라인의 폭보다 넓은 폭을 가지게 됨에 따라 상기 데이터라인의 신호간섭 및 개구율의 저하를 유발하게 된다.
- <58> 이하, 상기 본 발명의 제 2 실시예에 따른 제 2 마스크공정을 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
- <59> 도 6a 내지 도 6c는 도 4b 및 도 5b에 도시된 제 2 마스크공정을 구체적으로 나타내는 단면도이다.
- <60> 도 6a에 도시된 바와 같이, 상기 게이트전극(121)과 게이트라인(116) 및 게이트패드라인(116p)이 형성된 어레이 기관(110) 전면에 제 1 절연막(115a)과 제 2 도전막(130) 및 n+ 비정질 실리콘 박막(125)을 증착한다.
- <61> 다음으로, 도 6b에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 절연막(115a)과 제 2 도전막(130) 및 n+ 비정질 실리콘 박막(125)이 증착된 어레이 기관(110) 위에 포토레지스트와 같은 감광성 물질로 이루어진 소정의 감광막패턴(170)을

형성한다.

- <62> 이후, 도 6c에 도시된 바와 같이, 상기 감광막패턴(170)을 마스크로 그 하부의 상기 제 2 도전막과 n+ 비정질 실리콘 박막을 선택적으로 제거하여 상기 어레이 기관(110)의 화소부에 상기 제 2 도전막으로 이루어진 소오스 전극(122)과 드레인전극(123) 및 데이터라인(117)을 형성하는 동시에 상기 데이터패드부에 상기 제 2 도전막으로 이루어진 데이터패드라인(117p)을 형성한다.
- <63> 이때, 상기 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 및 데이터라인(117) 상부에는 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며 상기 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 및 데이터라인(117)과 동일한 형태로 패터닝된 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴(125')이 남아있으며, 상기 데이터패드라인(117p) 상부에는 상기 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며 상기 데이터패드라인(117p)과 동일한 형태로 패터닝된 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴(125'')이 남아 있게 된다.
- <64> 다음으로, 도 4c 및 도 5c에 도시된 바와 같이, 소오스전극(122)과 드레인전극(123)과 데이터라인(117) 및 데이터패드라인(117p)이 형성된 어레이 기관(110) 전면에 비정질 실리콘 박막을 형성한 후, 포토리소그래피공정(제 3 마스크공정)을 통해 선택적으로 제거함으로써 상기 게이트전극(121) 상부의 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 위에 상기 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 액티브패턴(124)을 형성하는 동시에 상기 게이트패드부에 상기 게이트패드라인(116p)의 일부를 노출시키는 게이트패드부 콘택홀(140)을 형성한다.
- <65> 이때, 상기 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴의 일부를 제거하여 상기 액티브패턴(124)과 소오스전극(122) 및 상기 액티브패턴(124)과 드레인전극(123) 사이에 오믹-콘택(ohmic contact)을 형성하는 오믹-콘택층(125n)을 형성하게 되며, 상기 데이터패드라인(117p) 상부에 남아있는 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴을 제거하게 된다.
- <66> 다만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 본 발명은 상기 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴의 패터닝과 상기 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴의 제거공정을 진행하지 않는 경우에도 적용 가능하다.
- <67> 여기서, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 상기 액티브패턴(124)과 게이트패드부 콘택홀(140)은 하프-톤 마스크 또는 회절마스크(이하, 하프-톤 마스크를 지칭하는 경우에는 회절마스크를 포함하는 것으로 한다)를 이용하여 한 번의 마스크공정(제 3 마스크공정)으로 동시에 형성하게 되는데, 이하 도면을 참조하여 상기 제 3 마스크공정을 상세히 설명한다.
- <68> 도 7a 내지 도 7g는 도 4c 및 도 5c에 도시된 제 3 마스크공정을 구체적으로 나타내는 단면도이다.
- <69> 도 7a에 도시된 바와 같이, 상기 소오스전극(122)과 드레인전극(123)과 데이터라인(117) 및 데이터패드라인(117p)이 형성된 어레이 기관(110) 전면에 비정질 실리콘 박막(120)을 형성한다.
- <70> 그리고, 도 7b에 도시된 바와 같이, 상기 어레이 기관(110) 전면에 포토레지스트와 같은 감광성물질로 이루어진 감광막(270)을 형성한 후, 하프-톤 마스크(180)를 통해 상기 감광막(270)에 선택적으로 광을 조사한다.
- <71> 이때, 본 발명의 제 1 실시예에 사용한 하프-톤 마스크(180)에는 조사된 광을 모두 투과시키는 제 1 투과영역(I)과 광의 일부만 투과시키고 일부는 차단하는 제 2 투과영역(II) 및 조사된 모든 광을 차단하는 차단영역(III)이 마련되어 있으며, 상기 하프-톤 마스크(180)를 투과한 광만이 감광막(270)에 조사되게 된다.
- <72> 이어서, 상기 하프-톤 마스크(180)를 통해 노광된 감광막(270)을 현상하고 나면, 도 7c에 도시된 바와 같이, 상기 차단영역(III)과 제 2 투과영역(II)을 통해 광이 모두 차단되거나 일부만 차단된 영역에는 소정 두께의 제 1 감광막패턴(270a)과 제 2 감광막패턴(270b)이 남아있게 되고, 모든 광이 투과된 제 1 투과영역(I)에는 상기 감광막이 완전히 제거되어 상기 비정질 실리콘 박막(120) 표면이 노출되게 된다.
- <73> 이때, 상기 차단영역(III)에 형성된 제 1 감광막패턴(270a)은 제 2 투과영역(II)을 통해 형성된 제 2 감광막패턴(270b)보다 두껍게 형성된다. 또한, 상기 제 1 투과영역(I)을 통해 광이 모두 투과된 영역에는 감광막이 완전히 제거되는데, 이것은 포지티브 타입의 포토레지스트를 사용했기 때문이며, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 네거티브 타입의 포토레지스트를 사용하여도 무방하다.
- <74> 다음으로, 도 7d에 도시된 바와 같이, 상기와 같이 형성된 제 1 감광막패턴(270a)과 제 2 감광막패턴(270b)을 마스크로 하여, 그 하부에 형성된 비정질 실리콘 박막(120)과 게이트절연막(115a)을 선택적으로 제거하게 되면, 상기 게이트패드라인(116p)의 일부를 노출시키는 게이트패드부 콘택홀(140)이 형성되게 된다.
- <75> 이후, 상기 제 1 감광막패턴(270a)과 제 2 감광막패턴(270b)의 일부를 제거하는 애싱(ashing)공정을 진행하게 되면, 도 7e에 도시된 바와 같이, 상기 제 2 투과영역(II)의 제 2 감광막패턴이 완전히 제거되게 된다.

- <76> 이때, 상기 제 1 감광막패턴은 상기 제 2 감광막패턴의 두께만큼이 제거된 제 3 감광막패턴(270a')으로 상기 차단영역(III)에 대응하는 액티브패턴영역에만 남아있게 된다.
- <77> 이후, 도 7f 및 도 7g에 도시된 바와 같이, 상기 남아있는 제 3 감광막패턴(270a')을 마스크로 하여 상기 비정질 실리콘 박막과 n+ 비정질 실리콘 박막의 일부를 제거함으로써 상기 게이트전극(121) 상부의 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 위에 상기 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 아일랜드 형태의 액티브패턴(124)을 형성한다.
- <78> 또한, 상기 액티브패턴(124) 하부에 남아있는 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴은 상기 제 3 마스크공정을 통해 소정영역이 제거되어 상기 액티브패턴(124)과 소오스전극(122) 및 액티브패턴(124)과 드레인전극(123) 사이를 오믹-콘택시키는 오믹-콘택층(125n)을 형성하게 된다.
- <79> 이때, 상기 데이터패드라인(117p) 상부에 남아있는 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴은 완전히 제거되어 상기 데이터패드라인(117p) 표면이 노출되게 된다.
- <80> 이와 같이 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액티브패턴(124)은 상기 게이트전극(124) 상부에만 아일랜드 형태로 형성됨에 따라 박막 트랜지스터의 오프전류가 감소되는 이점을 제공한다.
- <81> 또한, 본 발명의 제 1 실시예의 경우에는 채널의 길이를 정의하는 소오스전극(122)과 드레인전극(123) 및 액티브패턴(124)의 패터닝을 회절노광 또는 하프-톤 노광을 이용한 동일한 마스크공정을 통해 진행하지 않고 전술한 제 2 마스크공정 및 제 3 마스크공정을 통해 개별적으로 진행함으로써 채널 길이가 4 μ m 이하의 단-채널 박막 트랜지스터를 용이하게 제조할 수 있게 된다. 즉, 일반적으로 회절노광 또는 하프-톤 노광을 이용하여 액티브패턴과 소오스전극 및 드레인전극을 하나의 마스크공정을 통해 형성하는 경우에는 회절노광 또는 하프-톤 노광이 액티브패턴의 채널영역에 적용되어 채널의 길이가 상기 회절노광 또는 하프-톤 노광에 의해 좌우되게 된다. 이때, 상기 회절노광 또는 하프-톤 노광은 일반적인 포토리소그래피공정에 비해 분해능(resolution)이 세밀하지 않기 때문에 채널 길이가 짧은 단-채널을 형성하는데 어려움이 있게 된다.
- <82> 다음으로, 도 4d 및 도 5d에 도시된 바와 같이, 상기 액티브패턴(124)이 형성된 어레이 기관(110) 전면에 제 3 도전막을 형성한 후, 포토리소그래피공정(제 4 마스크공정)을 통해 선택적으로 제거함으로써 상기 어레이 기관(110)의 화소부에 상기 제 3 도전막으로 이루어진 화소전극(118)을 형성하는 한편 상기 데이터패드부 및 게이트패드부 각각에 상기 제 3 도전막으로 이루어진 데이터패드전극(127p) 및 게이트패드전극(126p)을 형성한다.
- <83> 이때, 상기 제 3 도전막은 상기 화소전극(118)과 데이터패드전극(127p) 및 게이트패드전극(126p)을 구성하기 위해 인듐-틴-옥사이드(Indium Tin Oxide; ITO) 또는 인듐-징크-옥사이드(Indium Zinc Oxide; IZO)와 같은 투과율이 뛰어난 투명한 도전물질을 포함한다.
- <84> 상기 본 발명의 제 1 실시예의 화소전극(118)은 상기 드레인전극(123)의 측면과 직접적으로 전기적으로 접속하게 되며, 상기 데이터패드전극(127p) 및 게이트패드전극(126p)은 각각 상기 데이터패드라인(117p) 및 게이트패드라인(116p)과 직접 또는 게이트패드부 콘택홀을 통해 전기적으로 접속하게 된다.
- <85> 이때, 전술한 바와 같이 상기 화소전극(118)의 일부는 그 하부의 게이트절연막(115a)을 사이에 두고 전단에 위치한 게이트라인(116)의 일부와 중첩하여 스토리지 커패시터(Cst)를 형성하게 된다.
- <86> 여기서, 본 발명의 제 2 실시예의 액정표시장치는 소오스전극과 드레인전극 및 데이터라인을 형성할 때 액티브패턴의 채널영역에 위치하는 게이트절연막의 일부를 제거해줌으로써 박막 트랜지스터의 전기적 특성을 향상시킬 수 있게 되는데, 이하 상기 제 2 실시예의 액정표시장치 및 그 제조방법에 대하여 상세히 설명한다.
- <87> 도 8a 내지 도 8d는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 어레이 기관의 제조공정을 순차적으로 나타내는 단면도이다.
- <88> 도 8a에 도시된 바와 같이, 유리와 같은 투명한 절연물질로 이루어진 어레이 기관(210)의 화소부에 게이트전극(221)과 게이트라인(216)을 형성하며, 상기 어레이 기관(210)의 게이트패드부에 게이트패드라인(216p)을 형성한다.
- <89> 이때, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 상기 게이트전극(221)과 게이트라인(216) 및 게이트패드라인(216p)은 제 1 도전막을 상기 어레이 기관(210) 전면에 증착한 후 포토리소그래피공정(제 1 마스크공정)을 통해 선택적으로 패터닝하여 형성하게 된다.
- <90> 다음으로, 도 8b에 도시된 바와 같이, 상기 게이트전극(221)과 게이트라인(216) 및 게이트패드라인(216p)이 형성된 어레이 기관(210) 전면에 제 1 절연막(215a)과 제 2 도전막 및 n+ 비정질 실리콘 박막을 증착한 후, 포토

리소그래피공정(제 2 마스크공정)을 통해 선택적으로 제거함으로써 상기 어레이 기판(210)의 화소부에 상기 제 2 도전막으로 이루어진 소오스전극(222)과 드레인전극(223) 및 데이터라인(217)을 형성하는 동시에 상기 데이터패드부에 상기 제 2 도전막으로 이루어진 데이터패드라인(217p)을 형성한다.

- <91> 이때, 상기 소오스전극(222)과 드레인전극(223) 및 데이터라인(217) 상부에는 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며 상기 소오스전극(222)과 드레인전극(223) 및 데이터라인(217)과 동일한 형태로 패터닝된 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴(225')이 남아있으며, 상기 데이터패드라인(217p) 상부에는 상기 n+ 비정질 실리콘 박막으로 이루어지며 상기 데이터패드라인(217p)과 동일한 형태로 패터닝된 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴(225'')이 남아 있게 된다.
- <92> 여기서, 상기 본 발명의 제 2 실시예에 따른 데이터라인(217)은 상기 제 1 실시예와 같이 그 하부에 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 액티브패턴의 테일이 존재하지 않게 되어 상기 액티브패턴의 테일에 의한 상기 데이터라인(217)의 신호간섭이 없게 된다.
- <93> 또한, 상기 본 발명의 제 2 실시예의 경우에는 상기 소오스전극(222)과 드레인전극(223) 및 데이터라인(217)을 형성할 때 하부의 게이트절연막(215a)의 일부를 제거하는 공정을 진행하게 된다. 그 결과 액티브패턴의 채널영역에 위치하는 게이트절연막(215a)의 일부가 제거되어 실질적으로 게이트절연막(215a)의 두께가 얇아짐에 따라 박막 트랜지스터의 전기적 특성이 향상되게 된다.
- <94> 도 9a 및 도 9b는 게이트절연막의 두께에 따른 박막 트랜지스터의 트랜스퍼(transfer)특성을 개략적으로 나타내는 그래프로써, 소오스전극과 드레인전극 사이의 전압이 1V인 경우에 게이트전압에 따른 소오스전극과 드레인전극 사이의 전류를 예를 들어 나타내고 있다. 이때, 도 9b는 도 9a에 도시된 트랜스퍼 곡선의 리니어(linear) 형태를 나타내고 있다.
- <95> 또한, 도 10은 게이트절연막의 두께에 따른 박막 트랜지스터의 출력(output)특성을 개략적으로 나타내는 그래프로써, 게이트전압이 20V인 경우에 소오스전극과 드레인전극 사이의 전압에 따른 전류특성을 예를 들어 나타내고 있다.
- <96> 도면에 도시된 바와 같이, 게이트절연막의 두께가 줄어들수록 트랜스퍼 곡선의 기울기가 증가하는 동시에 박막 트랜지스터의 온-전류(on current)가 증가하는 것을 알 수 있으며, 이때 트랜스퍼 곡선의 기울기가 증가하는 것은 박막 트랜지스터의 문턱전압이 낮아지는 것을 의미한다.
- <97> 다음으로, 도 8c에 도시된 바와 같이, 소오스전극(222)과 드레인전극(223)과 데이터라인(217) 및 데이터패드라인(217p)이 형성된 어레이 기판(210) 전면에서 비정질 실리콘 박막을 형성한 후, 포토리소그래피공정(제 3 마스크공정)을 통해 선택적으로 제거함으로써 상기 게이트전극(221) 상부의 소오스전극(222)과 드레인전극(223) 위에 상기 비정질 실리콘 박막으로 이루어진 액티브패턴(224)을 형성하는 동시에 상기 게이트패드부에 상기 게이트패드라인(216p)의 일부를 노출시키는 게이트패드부 콘택홀(240)을 형성한다.
- <98> 이때, 상기 제 1 n+ 비정질 실리콘 박막패턴의 일부를 제거하여 상기 액티브패턴(224)과 소오스전극(222) 및 상기 액티브패턴(224)과 드레인전극(223) 사이에 오믹-콘택을 형성하는 오믹-콘택층(225n)을 형성하게 되며, 상기 데이터패드라인(217p) 상부에 남아있는 제 2 n+ 비정질 실리콘 박막패턴을 제거하게 된다.
- <99> 다음으로, 도 8d에 도시된 바와 같이, 상기 액티브패턴(224)이 형성된 어레이 기판(210) 전면에서 제 3 도전막을 형성한 후, 포토리소그래피공정(제 4 마스크공정)을 통해 선택적으로 제거함으로써 상기 어레이 기판(210)의 화소부에 상기 제 3 도전막으로 이루어진 화소전극(218)을 형성하는 한편 상기 데이터패드부 및 게이트패드부 각각에 상기 제 3 도전막으로 이루어진 데이터패드전극(227p) 및 게이트패드전극(226p)을 형성한다.
- <100> 상기 본 발명의 제 2 실시예의 화소전극(218)은 상기 드레인전극(223)의 측면과 직접적으로 전기적으로 접속하게 되며, 상기 데이터패드전극(227p) 및 게이트패드전극(226p)은 각각 상기 데이터패드라인(217p) 및 게이트패드라인(216p)과 직접 또는 게이트패드부 콘택홀을 통해 전기적으로 접속하게 된다.
- <101> 이와 같이 구성된 상기 제 1 실시예 및 제 2 실시예의 어레이 기판은 화상표시 영역의 외곽에 형성된 실린트에 의해 컬러필터 기판과 대향하여 합착되게 되는데, 이때 상기 컬러필터 기판에는 상기 박막 트랜지스터와 게이트라인 및 데이터라인으로 빛이 새는 것을 방지하는 블랙매트릭스와 적, 녹 및 청색의 컬러를 구현하기 위한 컬러필터가 형성되어 있다.
- <102> 이때, 상기 컬러필터 기판과 어레이 기판의 합착은 상기 컬러필터 기판 또는 어레이 기판에 형성된 합착키를 통

해 이루어진다.

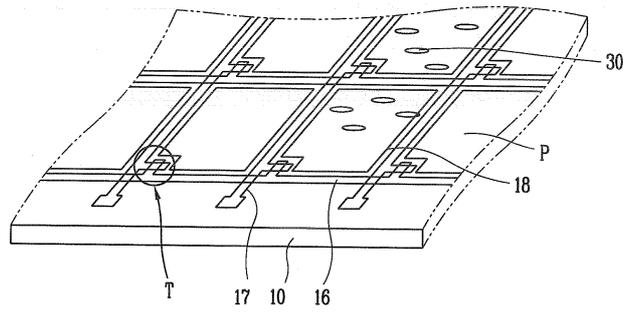
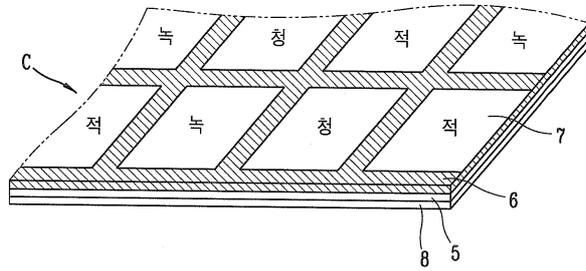
- <103> 상기 제 1 실시예 및 제 2 실시예는 액티브패턴으로 비정질 실리콘 박막을 이용한 비정질 실리콘 박막 트랜지스터를 예를 들어 설명하고 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며 본 발명은 상기 액티브패턴으로 다결정 실리콘 박막을 이용한 다결정 실리콘 박막 트랜지스터에도 적용된다.
- <104> 또한, 본 발명은 액정표시장치뿐만 아니라 박막 트랜지스터를 이용하여 제작하는 다른 표시장치, 예를 들면 구동 트랜지스터에 유기전계발광소자(Organic Light Emitting Diodes; OLED)가 연결된 유기전계발광 디스플레이장치에도 이용될 수 있다.
- <105> 상기한 설명에 많은 사항이 구체적으로 기재되어 있으나 이것은 발명의 범위를 한정하는 것이라기보다 바람직한 실시예의 예시로서 해석되어야 한다. 따라서 발명은 설명된 실시예에 의하여 정할 것이 아니고 특허청구범위와 특허청구범위에 균등한 것에 의하여 정하여져야 한다.

도면의 간단한 설명

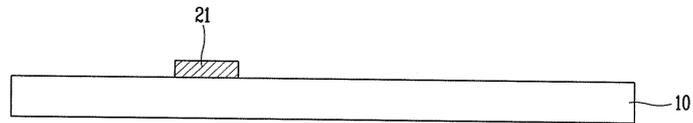
- <106> 도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 분해사시도.
- <107> 도 2a 내지 도 2e는 도 1에 도시된 액정표시장치에 있어서, 어레이 기관의 제조공정을 순차적으로 나타내는 단면도.
- <108> 도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치의 어레이 기관 일부를 개략적으로 나타내는 평면도.
- <109> 도 4a 내지 도 4d는 도 3에 도시된 어레이 기관의 III-III' 선에 따른 제조공정을 순차적으로 나타내는 단면도.
- <110> 도 5a 내지 도 5d는 도 3에 도시된 어레이 기관의 제조공정을 순차적으로 나타내는 평면도.
- <111> 도 6a 내지 도 6c는 도 4b 및 도 5b에 도시된 제 2 마스크공정을 구체적으로 나타내는 단면도.
- <112> 도 7a 내지 도 7g는 도 4c 및 도 5c에 도시된 제 3 마스크공정을 구체적으로 나타내는 단면도.
- <113> 도 8a 내지 도 8d는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 어레이 기관의 제조공정을 순차적으로 나타내는 단면도.
- <114> 도 9a 및 도 9b는 게이트절연막의 두께에 따른 박막 트랜지스터의 트랜스퍼(transfer)특성을 개략적으로 나타내는 그래프.
- <115> 도 10은 게이트절연막의 두께에 따른 박막 트랜지스터의 출력(output)특성을 개략적으로 나타내는 그래프.
- <116> ** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 **
- <117> 110,210 : 어레이 기관 116,216 : 게이트라인
- <118> 117,217 : 데이터라인 118,218 : 화소전극
- <119> 121,221 : 게이트전극 122,222 : 소오스전극
- <120> 123,223 : 드레인전극 124,224 : 액티브패턴

도면

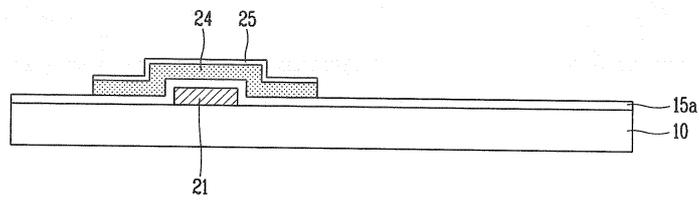
도면1



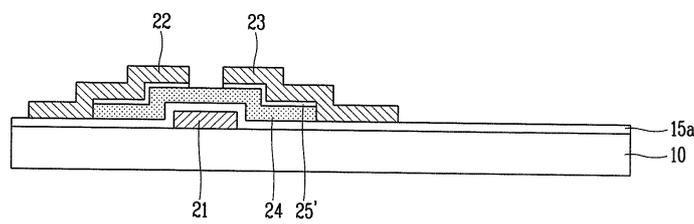
도면2a



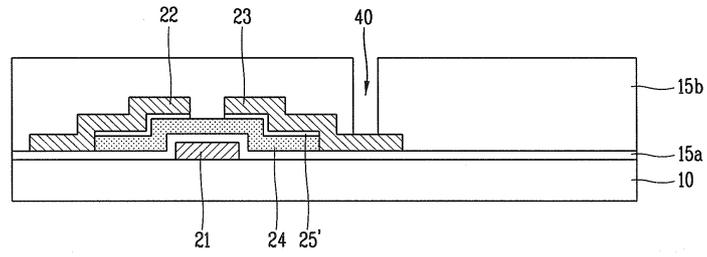
도면2b



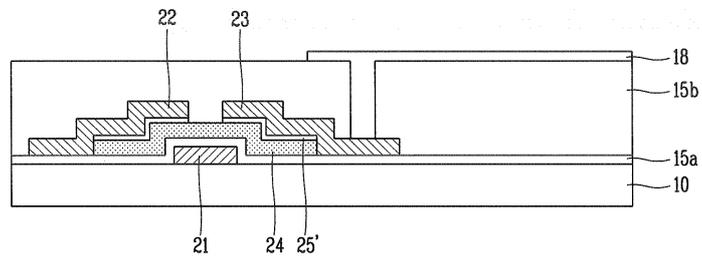
도면2c



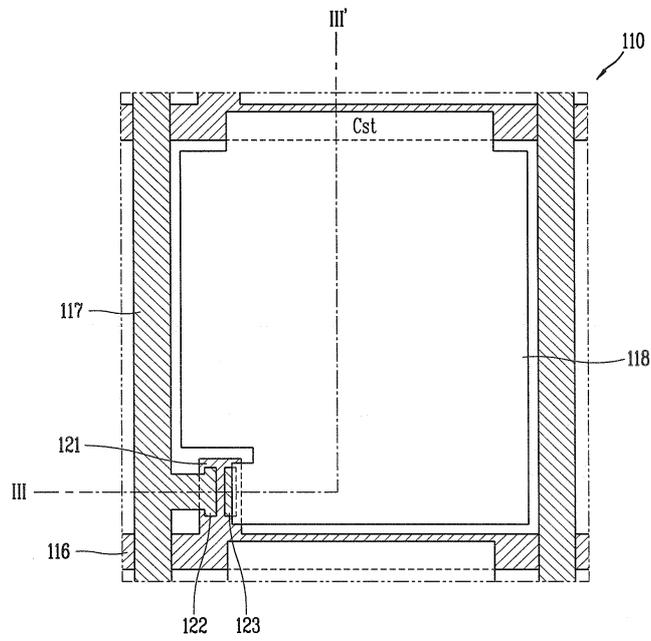
도면2d



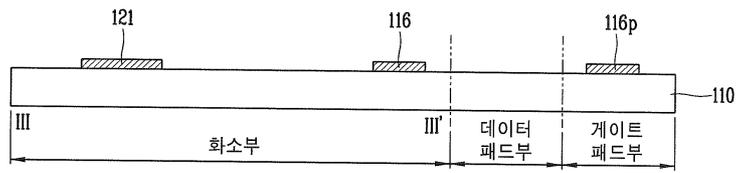
도면2e



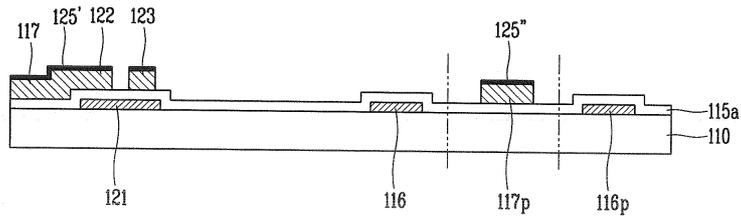
도면3



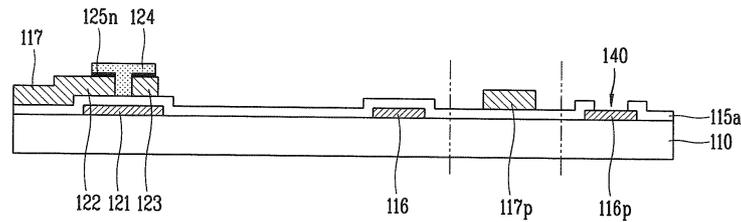
도면4a



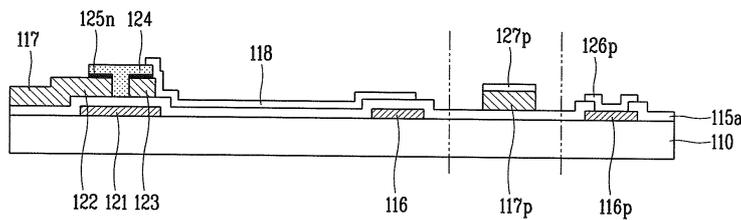
도면4b



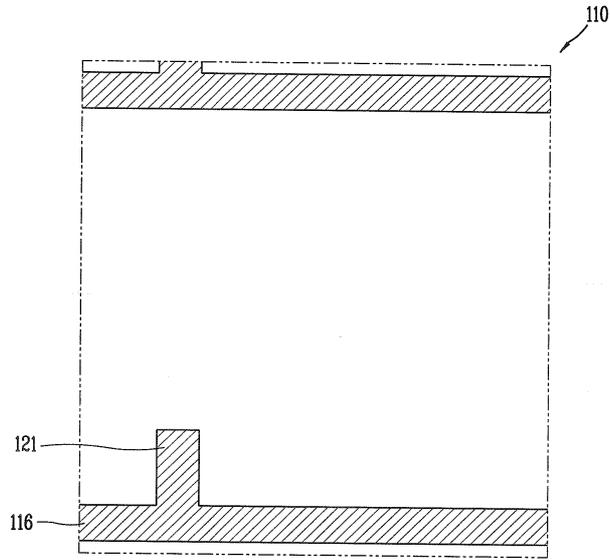
도면4c



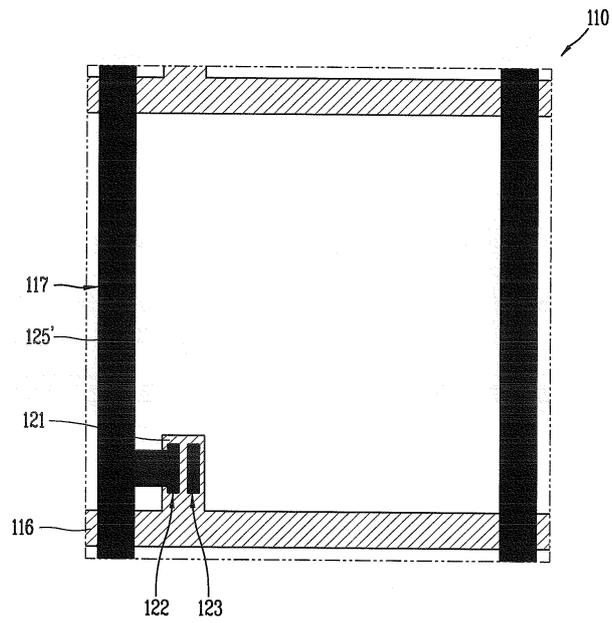
도면4d



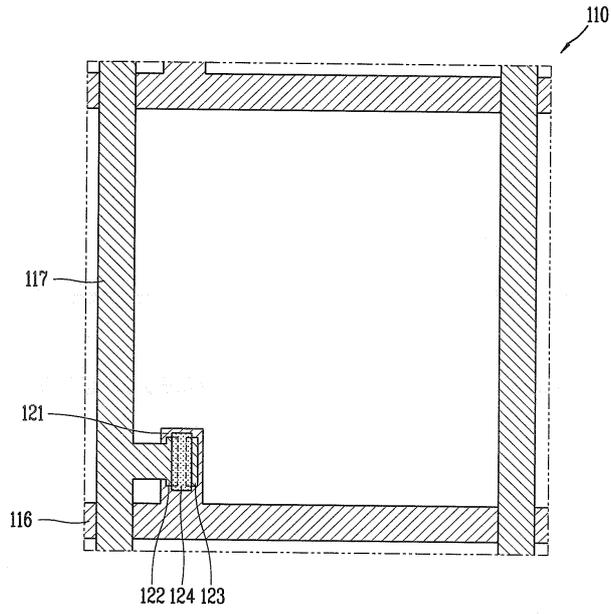
도면5a



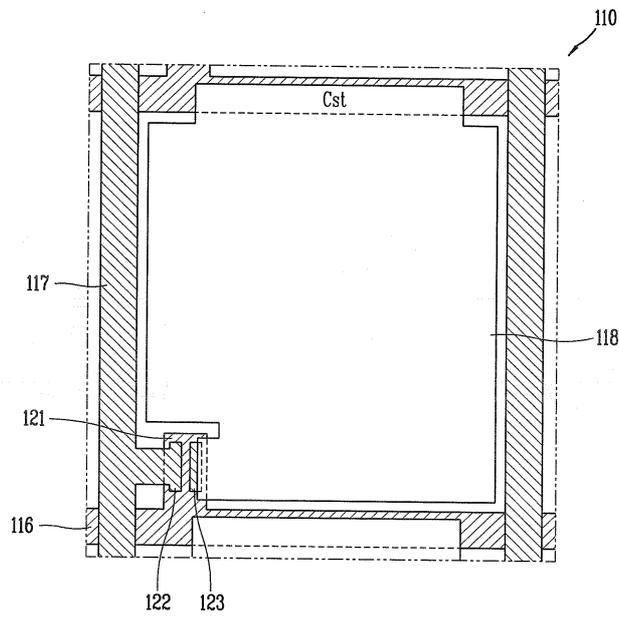
도면5b



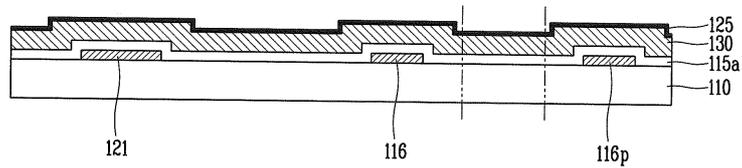
도면5c



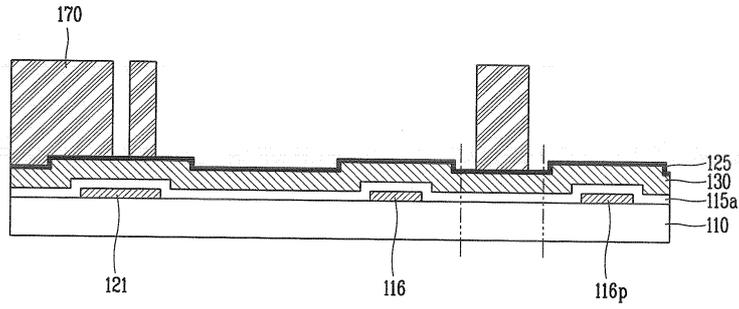
도면5d



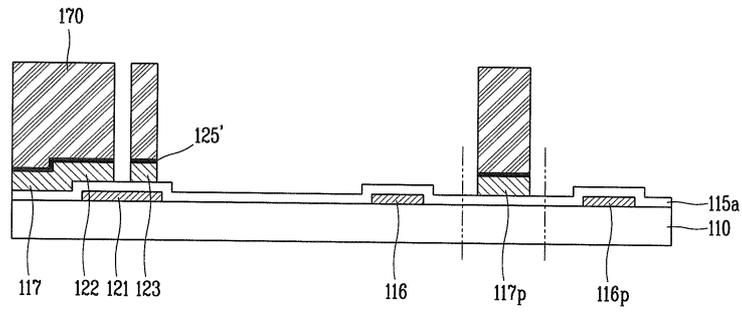
도면6a



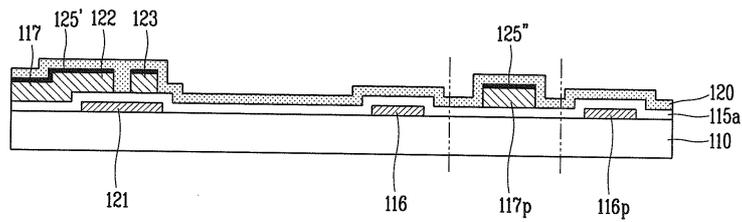
도면6b



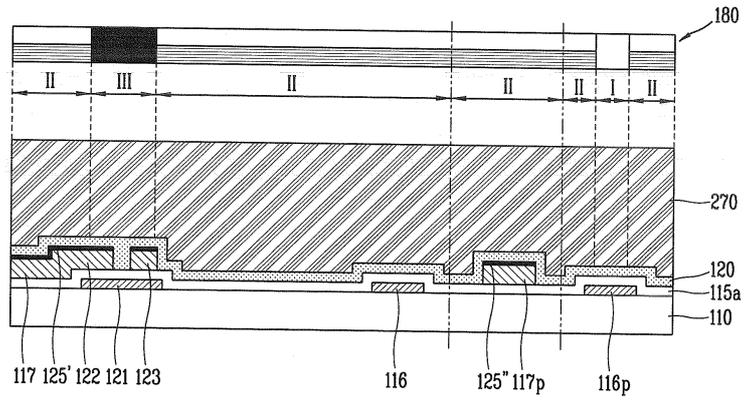
도면6c



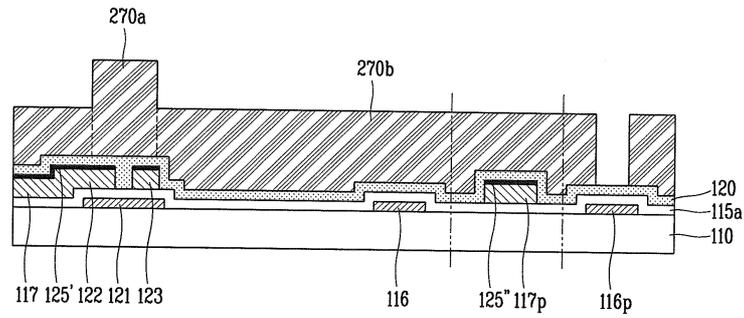
도면7a



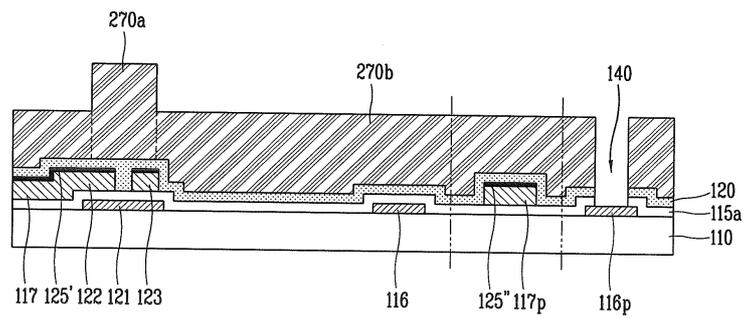
도면7b



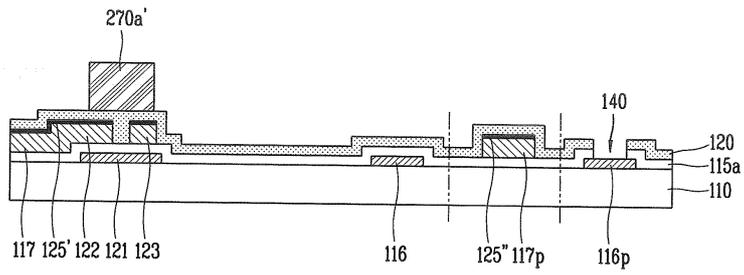
도면7c



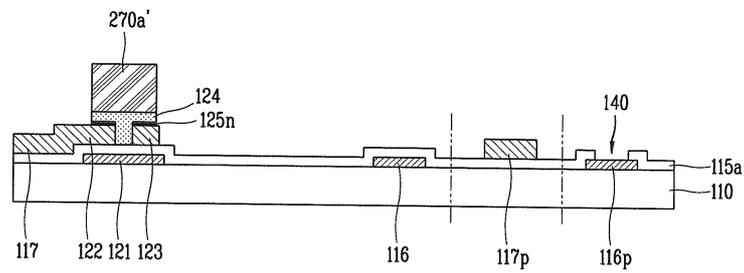
도면7d



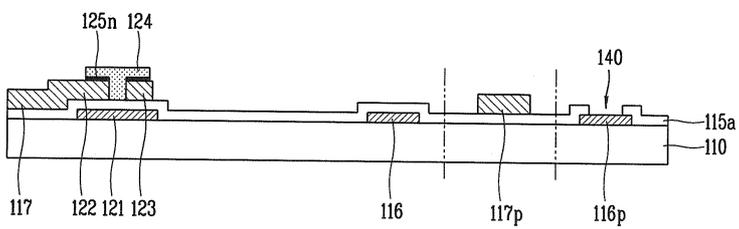
도면7e



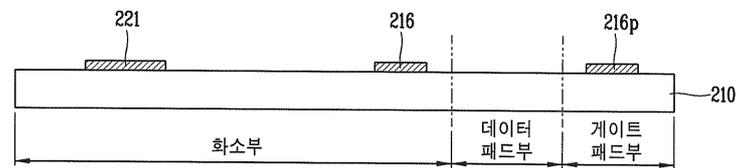
도면7f



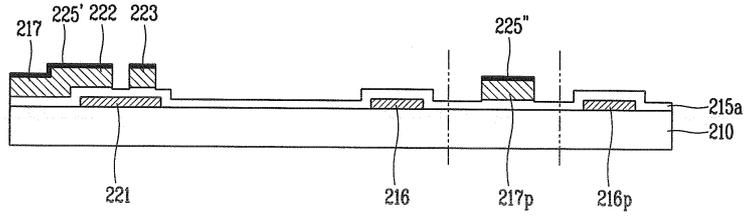
도면7g



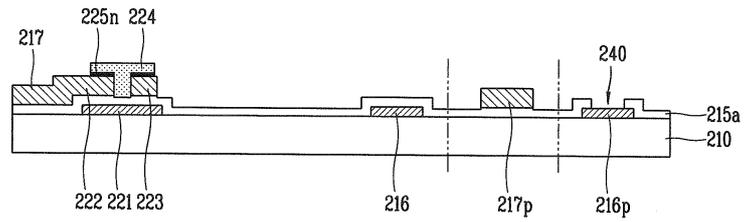
도면8a



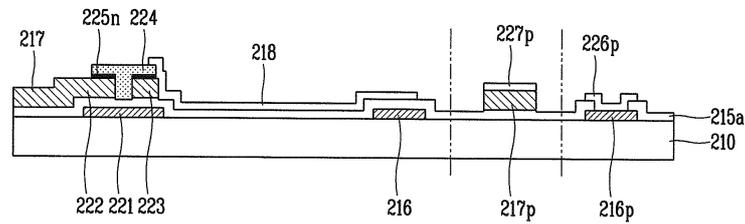
도면8b



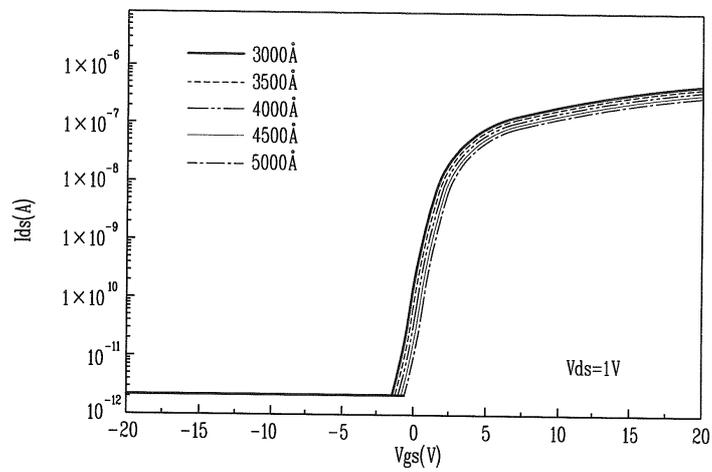
도면8c



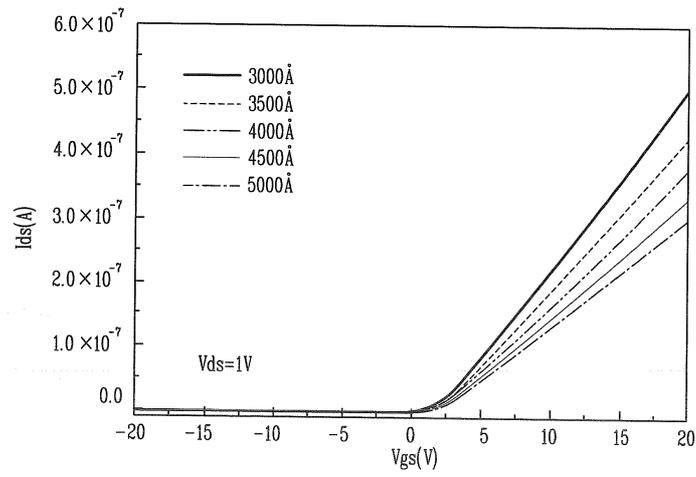
도면8d



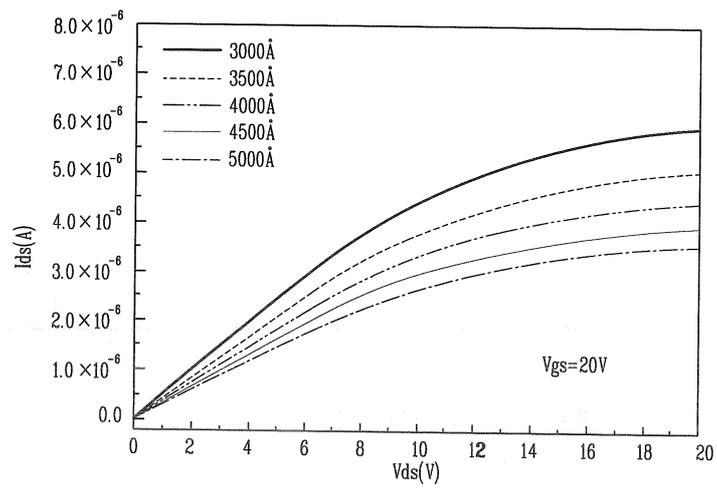
도면9a



도면9b



도면10



专利名称(译)	液晶显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020090020992A	公开(公告)日	2009-02-27
申请号	KR1020070085681	申请日	2007-08-24
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	AHN SUNG HOON		
发明人	AHN,SUNG HOON		
IPC分类号	G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/136286 G02F1/1343 G02F2001/136231 H01L29/786		
代理人(译)	PARK , JANG WON		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

所述的液晶显示设备，并且本发明的其制造方法的目的是通过消除另一方面保护层形成有四个掩模工艺的薄膜晶体管，形成在源电极的有源图案和漏电极，像素部分和数据焊盘部分以降低成本和栅极焊盘部分；通过第一掩模工艺在第一衬底的像素部分中形成栅电极和栅极线；在第一基板上形成栅极绝缘膜；通过第二掩模工艺在第一基板的像素部分中形成源电极和漏电极，并形成与栅线交叉的数据线并限定像素区域；通过第三掩模工艺在栅电极上的源电极和漏电极上形成有源图案；通过第四掩模工艺形成直接电连接到漏电极的侧表面的像素电极；并且将第一基板和第二基板结合在一起。因此，本发明的液晶显示装置是由四种一般在掩模结构来实现，通过不使用衍射曝光，以形成有源图案的困难阶段的 - 的特征在于，制造的通道（短通道）的TFT。另外，本发明的有源图案可以增加无栅电极的上方仅在岛形数据线下部存在，由此在开口区域中的像素，并且当因为它们不是由背光源的光暴露暴露于背光光束形成从而防止已经发生的波动噪声现象。

